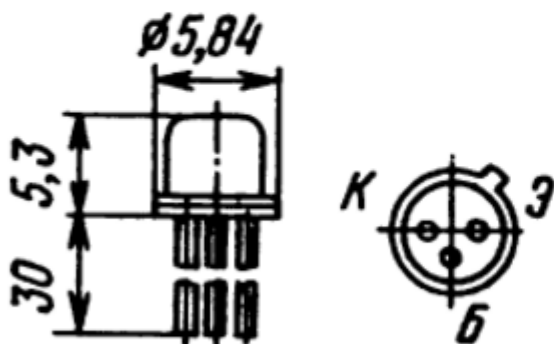


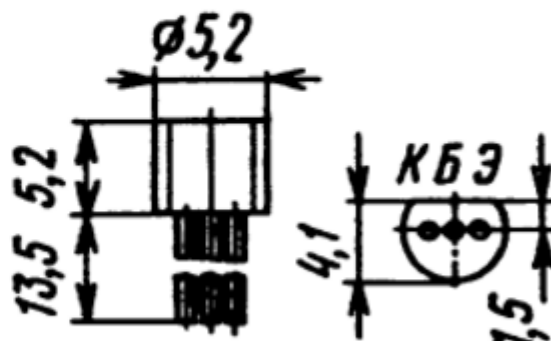
# Транзистор КТ201

## КТ201



Цоколевка транзистора КТ201

## КТ201-М



Цоколевка транзистора КТ201-М

### Параметры транзисторов КТ201, КТ201-М

Параметр	Обозначение	Маркировка	Условия	Значение	Ед. изм.
Аналог		КТ201А		2N2432	
		КТ201АМ		2N3565	
		КТ201Б		2N2432А	
		КТ201БМ		МРS9601	
		КТ201В		2N1590	
		КТ201ВМ		МРS9600	
		КТ201Г		2N2617	
		КТ201ГМ		2N2932	
		КТ201Д		2N2617	
		КТ201ДМ		2N2933	
Структура			—	n-p-n	

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора	$P_{K \max}, P_{K}^*, \tau_{\max}, P_{K}^{**}, \text{и } \max$	КТ201А(М)	90 °С	150	мВт
		КТ201Б(М)	—	150	
		КТ201В(М)	—	150	
		КТ201Г(М)	—	150	
		КТ201Д(М)	—	150	
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером	$f_{гр}, f_{h21б}^*, f_{h21э}^{**}, f_{\max}^{***}$	КТ201А(М)	—	$\geq 10$	МГц
		КТ201Б(М)	—	$\geq 10$	
		КТ201В(М)	—	$\geq 10$	
		КТ201Г(М)	—	$\geq 10$	
		КТ201Д(М)	—	$\geq 10$	
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера	$U_{КБО \text{ проб.}}, U_{КЭР}^* \text{ проб.}, U_{КЭО}^{**} \text{ проб.}$	КТ201А(М)	0.05к	20	В
		КТ201Б(М)	0.05к	20	
		КТ201В(М)	0.05к	10	
		КТ201Г(М)	0.05к	10	
		КТ201Д(М)	0.05к	10	
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора	$U_{ЭБО \text{ проб.}}$	КТ201А(М)	—	20	В
		КТ201Б(М)	—	20	
		КТ201В(М)	—	10	
		КТ201Г(М)	—	10	
		КТ201Д(М)	—	10	
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	$I_{K \max}, I_{K}^*, \text{и } \max$	КТ201А(М)	—	20(100*)	мА
		КТ201Б(М)	—	20(100*)	
		КТ201В(М)	—	20(100*)	
		КТ201Г(М)	—	20(100*)	
		КТ201Д(М)	—	20(100*)	

Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера	$I_{КБ0}, I_{КЭR}^*, I_{КЭ0}^{**}$	КТ201А(М)	20 В	$\leq 1$	мкА
		КТ201Б(М)	20 В	$\leq 1$	
		КТ201В(М)	20 В	$\leq 1$	
		КТ201Г(М)	20 В	$\leq 1$	
		КТ201Д(М)	20 В	$\leq 1$	
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером	$h_{21Э}, h_{21Э}^*$	КТ201А(М)	(1 В; 5 мА)	20...60	
		КТ201Б(М)	(1 В; 5 мА)	30...90	
		КТ201В(М)	(1 В; 5 мА)	30...90	
		КТ201Г(М)	(1 В; 5 мА)	70...210	
		КТ201Д(М)	(1 В; 5 мА)	30...90	
Емкость коллекторного перехода	$C_K, C_{12Э}^*$	КТ201А(М)	—	$\leq 20$	пФ
		КТ201Б(М)	—	$\leq 20$	
		КТ201В(М)	—	$\leq 20$	
		КТ201Г(М)	—	$\leq 20$	
		КТ201Д(М)	—	$\leq 20$	

Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером	$r_{кЭ\text{ нас}}, r_{бЭ\text{ нас}}^*$	КТ201А(М)	—	—	Ом
		КТ201Б(М)	—	—	
		КТ201В(М)	—	—	
		КТ201Г(М)	—	—	
		КТ201Д(М)	—	—	
Коэффициент шума транзистора	$K_{ш}, r_{br}^*, P_{вых}$	КТ201А(М)	—	—	Дб, Ом, Вт
		КТ201Б(М)	—	—	
		КТ201В(М)	—	—	
		КТ201Г(М)	—	—	
		КТ201Д(М)	1 кГц	$\leq 15$	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте	$\tau_k, t_{рас}^*, t_{выкл}^{**}, t_{пк}^{***}(\text{нс})$	КТ201А(М)	—	—	нс
		КТ201Б(М)	—	—	
		КТ201В(М)	—	—	
		КТ201Г(М)	—	—	
		КТ201Д(М)	—	—	